

## 1N4148S(玻封)

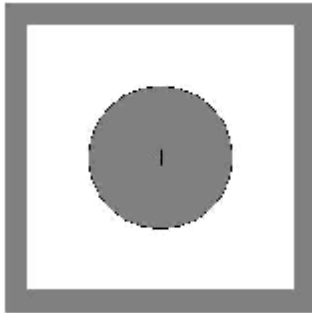
### ■用途:

\* 用作高压、高速开关应用。

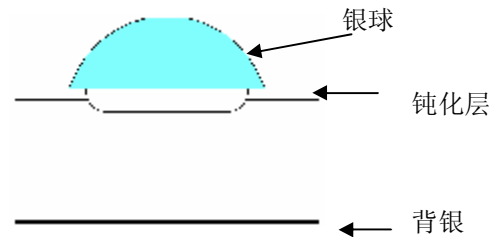
### ■特征

- \* 较低的正向压降
- \* 较小的总电容
- \* 较短的反向恢复时间
- \* 用于 DO35 封装

### ■管芯示意图:



### ■外形示意图:



### ■芯片结构:

芯片尺寸	240 $\mu$ m $\times$ 240 $\mu$ m
芯片厚度(含银点)	145 $\pm$ 10 $\mu$ m
金属层	正面: 银点 (35 $\pm$ 10 $\mu$ m) 背面: 银 (1.9 $\pm$ 0.2 $\mu$ m)

### ■参数规范及参数测试值:

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
正向压降	$V_F$ (1)	$I_F=10\text{mA}$		1.0	V
	$V_F$ (2)	$I_F=100\text{mA}$		1.2	V
反向电压	$V_R$	$I_R=0.1\text{mA}$	100		V
反向漏电流	$I_R$ (1)	$V_R=20\text{V}$		25	nA
	$I_R$ (2)	$V_R=75\text{V}$		100	nA
总电容	$C_T$	$V_R=0, f=1\text{MHz}$		3.0	PF
反向恢复时间	$t_{rr}$	$I_F=I_R=10\text{mA},$ $I_{rr}=0.1\times I_R$		4.0	ns